

## 明志科技大學材料工程系

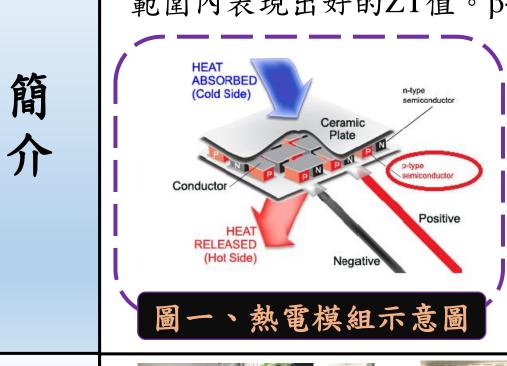
# 106學年四技專題製作競賽

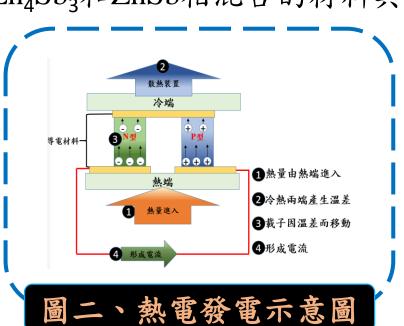
#### 明志科技大學

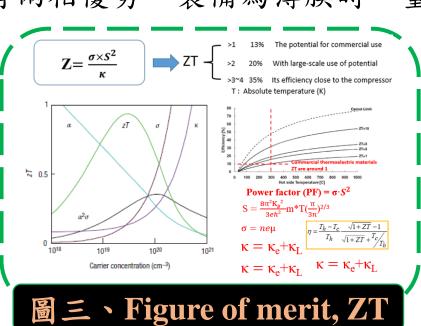
MING CHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

#### 離子束輔助蒸鍍 ZnSb 合金薄膜之顯微結構及電性質研究 班級/學生: 材四甲黃奕鑫/ 材四乙黃志豪 指導教授:陳勝吉 教授

熱電材料是一種能夠在沒有其他特定外力或機件的協助下,使熱與電兩種不同型態的能量互相轉換的功能性半導體材料。由於Zn的蘊藏量在自然界中豐富。在相同的工作溫度範圍,PbTe因鉛含有毒而使Zn₄Sb₃化合物作為近年有希望的熱電材料,它在200~400℃相對溫和的溫度範圍內表現出好的ZT值。β-Zn₄Sb₃和ZnSb相混合的材料具有兩相優勢,製備為薄膜時,量子限制效應大,兩者都能提高其熱電性能。

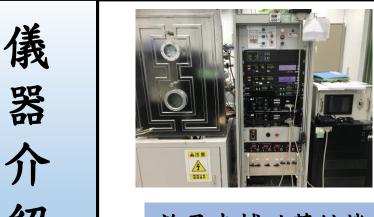








鍍膜參數









XTHAT PRO " PASSAS CICAL PASSAS



紹 離子束輔助蒸鍍機

高真空退火爐

輪廓儀

Hall

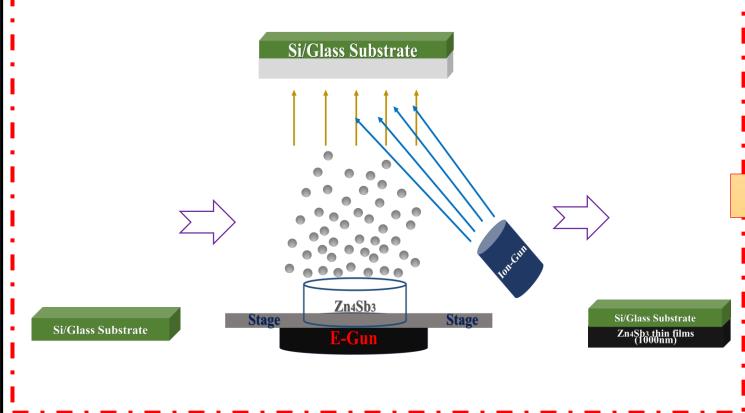
SEM

XRD

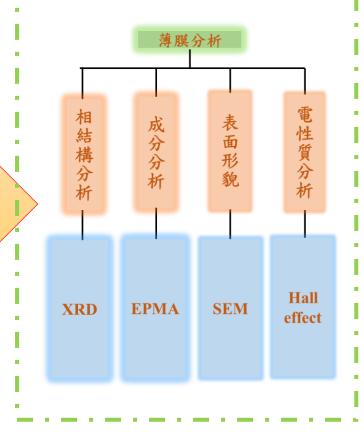
**EPMA** 

參數設定

實驗步驟

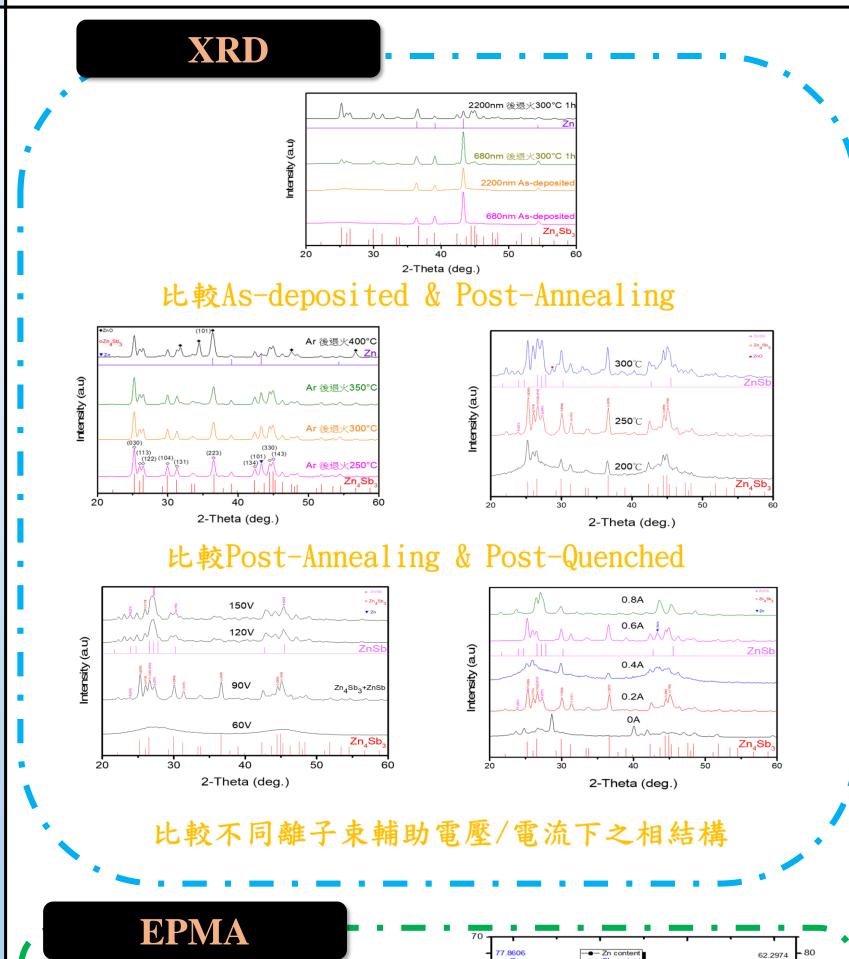


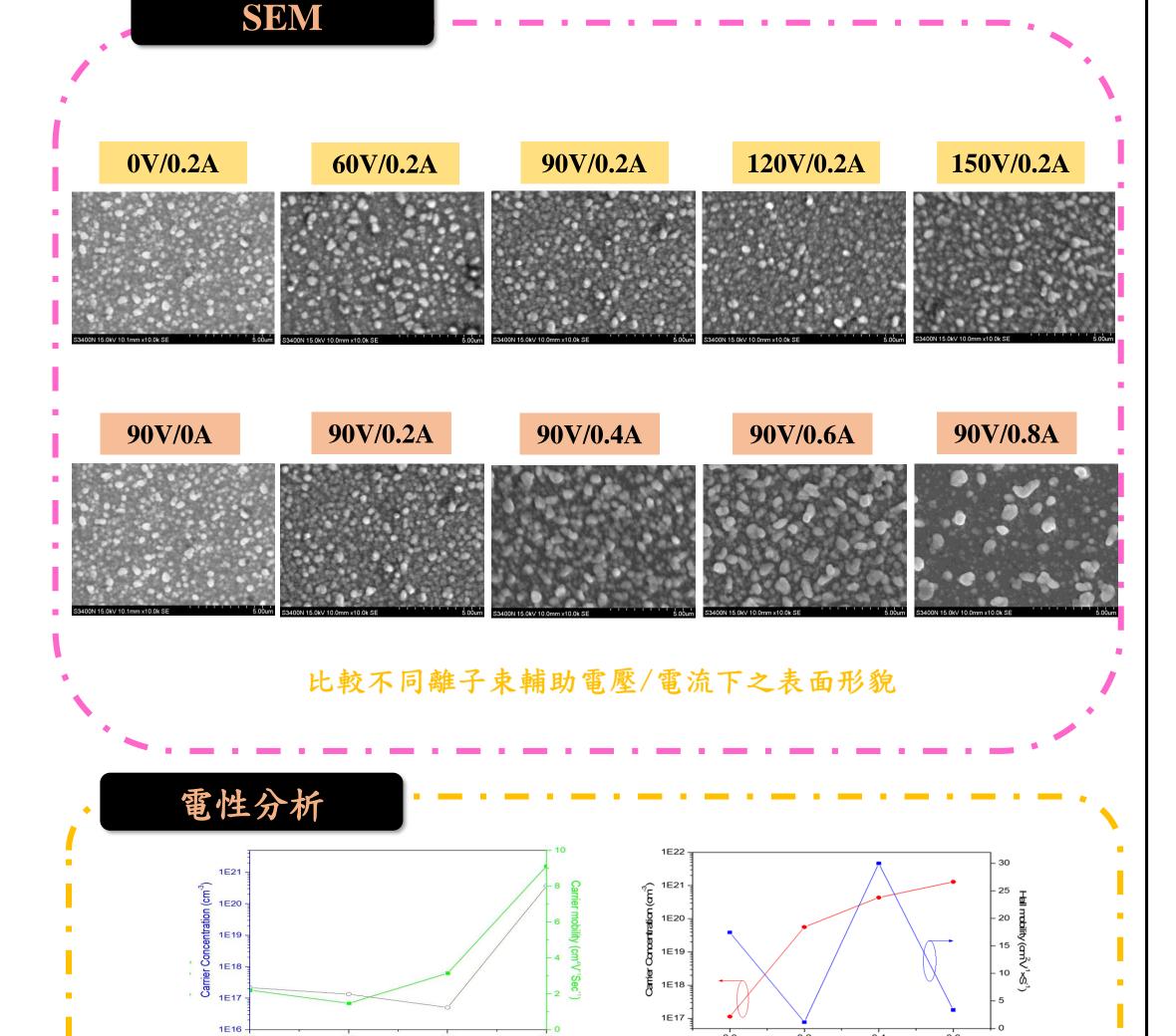




į	Background pressure	<8× 10 <sup>-6</sup> torr		<	<8× 10 <sup>-6</sup> torr		
į	Working pressure	1.4 × 10 <sup>-4</sup> torr 5.2 sccm		1.	1.4× 10 <sup>-4</sup> torr 5.2 secm		
!	Ar flow rate						
!	Power			2.5%	2.5%		
I	Ion Current	<b>0A</b>	0.2A	0.4A	0.6A	0.8A	
i	Ion Voltage	<b>0V</b>	60V	90V	120V	150V	
i	Substrate	glass / silicon		gl	glass / silicon		
į	Substrate rotation				10 rpm		
ļ	Film thickness	1000 nm			1000 nm		

參數設定





比較不同的離子束輔助電流下As-deposited & Post-Quenched之霍爾電性

### 結論

研

究

成

果

(1)後退火會改善結晶性,由於降溫速率的不同,爐冷退火會析出Zn相,淬火析出ZnSb相。

 $I_{Ar}(A)$ 

- (2)由EPMA和霍爾電性分析得知, Zn的增加會導致載子濃度的提高。
- (3)在離子束電壓90V,離子束電流0.2A時,得到最佳的Zn4Sb3相+ZnSb相,其結晶性與電性質載子濃度5.63X10<sup>19</sup>為較佳。